

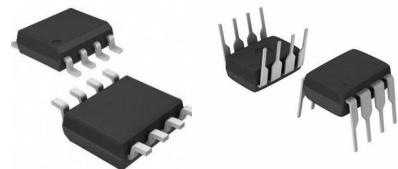
HX75HVD12P/HX75HVD12DR 总线收发器电路

HX75HVD12P/HX75HVD12DR是一款具有 3.3V/5V 电压供应、半双工通信、具备±15KV ESD保护的 RS485/RS-422 收发器电路。该电路内部包含一路驱动器和一路接收器。

HX75HVD12P/HX75HVD12DR具有增强的摆率限制，有助于降低输出电磁干扰（EMI），并减少由不匹配的终端连接引起的反射，实现无误码数据传输速率达到500kbps。

HX75HVD12P/HX75HVD12DR芯片的接收器输入阻抗为 1/8 单位负载，允许最多可挂载

256 个收发器在总线上进行半双工通信。所有驱动器输出均提供±15kV 的人体模式 ESD 保护。此芯片采用 SOP8和PDIP-8封装，并可在-40°C至+125°C的温度范围内工作。



SOP-8

PDIP-8

特点

- 3.3V/5V 电源电压
- 静电保护（ESD）：A/B±15KV，符合人体模式（HBM）标准
- 具有 1/8 单位负载，总线允许挂载多达 256 个收发器
- 最高支持 500kbps 的无误码数据传输
- 带有 Fail-safe 功能
- 采用 SOP8和PDIP8封装。

应用

- 工业控制
- 电表
- 工业电机驱动
- 隔离型 RS485 接口
- 自动化暖通空调（HVAC）系统

芯片引脚描述

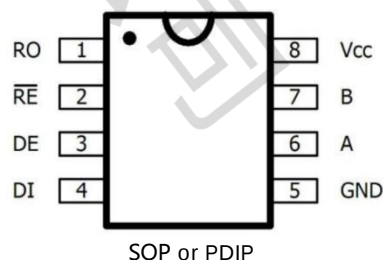
编号	名称	功能	说明
1	RO	接收器 数据输出	当接收器使能时，经过极性判断后，根据以下条件： - 若 $V(A)-V(B) > -50\text{mV}$ ，则 RO 输出高电平。 - 若 $V(A)-V(B) < -200\text{mV}$ ，则 RO 输出低电平。 其中 A 和 B 表示经过极性判断后芯片的同相和反相端。
2	$\overline{\text{RE}}$	接收器 输出使能	当接收器输出使能时，如果 RE 接低电平，RO 输出有效；如果 RE 接高电平，接收器将被关断。同时，当 RE 为高电平，DE 为低电平时，整个芯片处于关断状态。
3	DE	驱动器 输出使能	当 DE 置为高电平时，驱动器输出使能；当 DE 置为低电平时，驱动器关断，驱动器输出为高阻态。同时当 RE 为高电平，DE 为低电平时，整个芯片处于关断状态。
4	DI	驱动器 数据输入	当驱动器输入 DI 为低电平时，强制同相输出为低电平，反相输出为高电平；当 DI 为高电平时，强制同相输出为高电平，反相输出为低电平。
5	GND	地	地
6	A	驱动器数据输出/接收器数据输入	在总线接口中，驱动器的同相输出端连接到接收器的同相输入端。
7	B	驱动器数据输出/接收器数据输入	在总线接口中，驱动器的反相输出端连接到接收器的反相输入端。
8	Vcc	电源	电源

驱动器真值表

输入			输出	
RE	DE	DI	B	A
X	1	1	0	1
X	1	0	1	0
0	0	X	Z	Z
1	0	X	关断	

接收器真值表

输入			输出
RE	DE	A-B	RO
0	X	$\geq -50\text{mV}$	1
0	X	$\leq -200\text{mV}$	0
0	X	开路/短路	1
1	1	X	Z
1	0	X	关断



直流电气参数

极限参数

符号	参数名称	最小值	最大值	单位
VCC	电源电压	3.0	+6.0	V
DE, RE	控制输入电压	-0.3	+6.0	V
DI	驱动输入电压	-0.3	+6.0	V
A, B	驱动输出电压/接收输入	-8.0	+13.0	V
TSTG	存储温度范围	-65	+150	°C
TOP	工作温度范围	-40	+125	°C
P _D	SOP-8 (+70°C以上)		471	mW
T _L	焊锡温度 (10 秒)		+300	°C

直流特性 (V_{CC}=+3.3V±5%, TA=25°C)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
驱动器						
差分驱动输出(无负载)	VOD1	图 1	2			V
差分驱动输出	VOD2	R=50Ω(RS-422) 图 1	1.2			V
		R=27Ω(RS-485) 图 1	1.2			V
差分输出幅值变化 ¹	ΔVOD	R=50Ω or R=27Ω 图 1			0.2	V
驱动器输出共模电平	VOC	R=50Ω or R=27Ω 图 1	0		3	V
驱动器输出共模电平变化	ΔVOC	R=50Ω or R=27Ω 图 1			0.2	V
输入高电平	VIH1	DE,DI, RE	2.0			V
输入低电平	VIL1	DE,DI, RE			0.8	V
输入迟滞	VHYS	DE,DI, RE		100		mV
输入电流	IIN1	DE,DI, RE ²			±2	uA
输入电流(A 与 B)	IIN4	DE=GND, VIN=12V			125	uA
		VCC=GNDor5.25V VIN=-7V	-75			uA
驱动器输出短路电流	IOD1	-7V≤VOUT≤VCC	-100			mA
		0V≤VOUT≤12V			100	mA
		0V≤VOUT≤VCC	±25			mA
接收器						
接收器差分输入阈值电压	VTH	-7V≤VCM≤+12V	-200		-50	mV
接收器差分输入阈值电压迟滞	ΔVTH			40		mV
接收器输出高电平	VOH	IO=-4mA,VID=1V	Vcc-0.4			V
接收器输出低电平	VOL	IO=4mA,VID=-1V	0		0.4	V
接收器输出高阻态漏电流	IOZR	0.4V≤VO≤2.4V			±1	uA
接收器输入阻抗	RIN	-7V≤VCM≤+12V	96			KΩ
接收器输出短路电流	IOSR	0V≤VRO≤VCC	+7		+95	mA
供电电流						
静态供电电流	ICC	No load, RE=DI=GNDorVcc	DE=VCC		450	uA
			DE=GND		450	
关断电流	ISHDN	DE=GND, RE=Vcc	0.1		10	uA
静电保护特性						
静电保护 (A 管脚,B 管脚)		接触放电模型	±12			KV
		人体模型	±15			
		人体模型	±4			

交流特性 (V_{CC}=3.3V±5%, TA=25°C)

参数	符号	条件	最小	典型	最大	单位
驱动器输入输出延时	tDPLH	RDIF=54Ω, CL=54pF 图 3, 5	25	72	10	ns
	tDPLH		25	72	10	ns
驱动器输入输出延时之差	tDSKEW	RDIF=54Ω CL1=CL2=100pF 图 3, 5		-3	±1	ns
驱动器上升、下降时间	tDR, tDF	RDIF=54Ω CL1=CL2=100pF 图 3, 5	40	70	12	ns
最大速率	fMAX			50		kb
驱动器使能到输出为高电平	tDZH	CL=100pF, S2 关断 图 4, 6			25	ns
驱动器使能到输出为低电平	tDZL	CL=100pF, S1 关断 图 4, 6			25	ns
驱动器从输出低到关断时间	tDLZ	CL=15pF, S1 关断 图 4, 6			500	ns
驱动器从输出高到关断时间	tDHZ	CL=15pF, S2 关断 图 4, 6			500	ns
接收器输入输出延时	tRPLH	VID≥2.0V;				
	tRPHL	VID 上升下降时间小于 15ns 图 7, 9		125	250	ns
tRPLH-tRPHL 接收器输入输出延时之差	tRSKD	VID 上升下降时间小于 15ns 图 7, 9		10	±50	ns
接收器使能到输出低	tRZL	CL=100pF, S1 关断 图 2, 8		20	120	ns
接收器使能到输出高	tRZH	CL=100pF, S2 关断 图 2, 8		20	120	ns
接收器从输出高到关断	tRHZ	CL=100pF, S1 关断 图 2, 8		20	120	ns
接收器从输出低到关断	tRLZ	CL=100pF, S2 关断 图 2, 8		20	120	ns
芯片关断时间	tSHDN	³	50	200	600	ns
从芯片关断到驱动器使能, 到输出为高电平	tDZH(SH DN)	CL=15pF, S2 关断 图 4, 6			4500	ns
从芯片关断到驱动器使能, 到输出为低电平	TdZL(SH DN)	CL=15pF, S1 关断 图 4, 6			4500	ns
从芯片关断到接收器使能, 到输出为高电平	tRZH(SH DN)	CL=100pF, S2 关断 图 2, 8			3500	ns
从芯片关断到接收器使能, 到输出为低电平	tRZL(SH DN)	CL=100pF, S1 关断 图 2, 8			3500	ns

注: 1 ΔVOD 和 ΔVOC 分别表示 DI 变化时 VOD 和 VOC 的变化量。

2 电流流入器件时为正, 流出器件时为负; 除非特别说明, 所有电压以地为参考点。

3 当 R_{ON}(E)=1 且 DE=0 时, HX75HVD12P/HX75HVD12DR 进入关断状态。如果关断状态持续时间小于 50ns, 则芯片不会进入关断状态。如果关断状态持续时间超过 600ns, 则芯片确保进入关断状态。

功能描述

总线负载

HX75HVD12P/HX75HVD12DR芯片支持最多256个收发器挂接在同一总线上。标准 RS-485 接收器的输入阻抗为 12K Ω (1个单位负载)，而 HX75HVD12P/HX75HVD12DR具有 1/8 单位负载的输入阻抗 (96K Ω)，允许最多 256 个收发器挂接在同一总线上。这些器件可以任意组合，或者与其他 RS485 收发器组合使用，只要总负载不超过 32 个单位负载即可挂接在同一总线。

低功耗关断模式

当 RE 为高电平，DE 为低电平时，芯片进入低功耗关断模式。关断电流典型值为 1.8 μ A。RE 和 DE 可以同时驱动，如果 RE 为高电平，DE 为低电平保持时间小于 50ns，芯片不会进入关断模式；如果保持时间超过 600ns，芯片会确保进入关断模式。

降低 EMI 和反射

HX75HVD12P/HX75HVD12DR的限摆率驱动器可以降低电磁干扰 (EMI)，并降低由于不恰当的终端匹配电缆所引起的反射，实现最高 500kbps 的无误码数据传输。

驱动器输出保护

HX75HVD12P/HX75HVD12DR具有过大电流和功耗过大保护机制。一种是过流保护电路，当总线异常导致芯片电流过大时，芯片内部的过流保护电路起作用，来保证驱动电流不会超过设定值。另一种是过温保护，当芯片功耗太大，温度上升时，过温保护电路保证芯片不会损坏。如果芯片进入过温保护状态，驱动器输出为高阻态。

典型应用

HX75HVD12P/HX75HVD12DR常用于双向数据通信的多点网络。为了降低反射，应当在传输线的两端以其特性阻抗进行终端匹配，主干线以外的分支线路的长度应尽可能短。

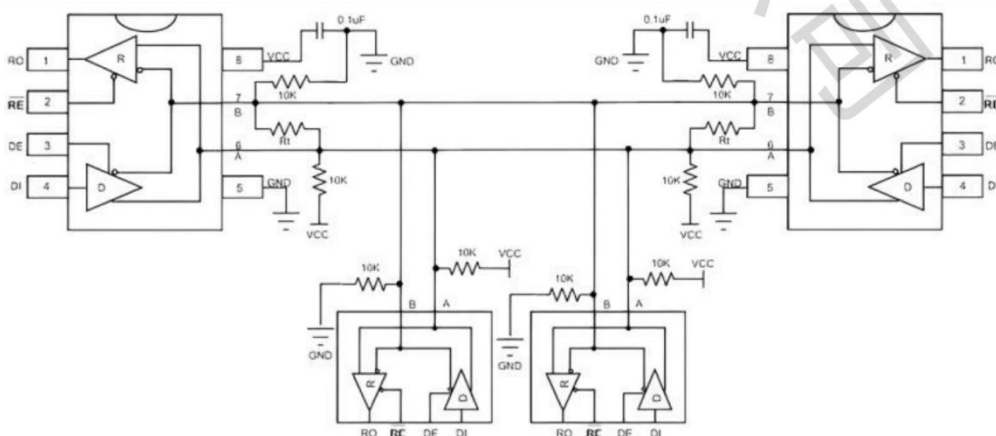
静电保护

HX75HVD12P/HX75HVD12DR的所有管脚都具有静电泄放保护电路，以防止人手触摸或者装配时的静电放电事件对芯片造成损坏。驱动器的输出和接收器的输入管脚采用 R_t 为特征匹配阻抗，典型值为120 Ω 增强的ESD保护电路，可以抵抗 ± 15 kV 的人体模式ESD冲击而不会损坏。所有ESD保护电路在正常工作时处于关断状态，不消耗电流。在ESD事件后，HX75HVD12P/HX75HVD12DR可以保证正常工作，而不会出现闩锁或损坏情况。

型和 ± 12 kV IEC61000-4-2 接触放电。

ESD 保护性能测试方法包括 ± 15 kV 人体模

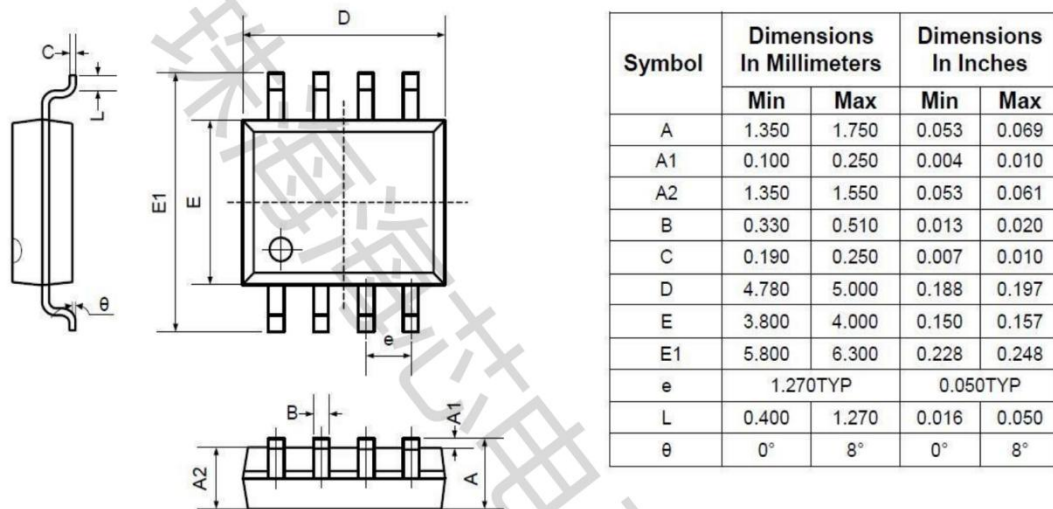
典型应用图



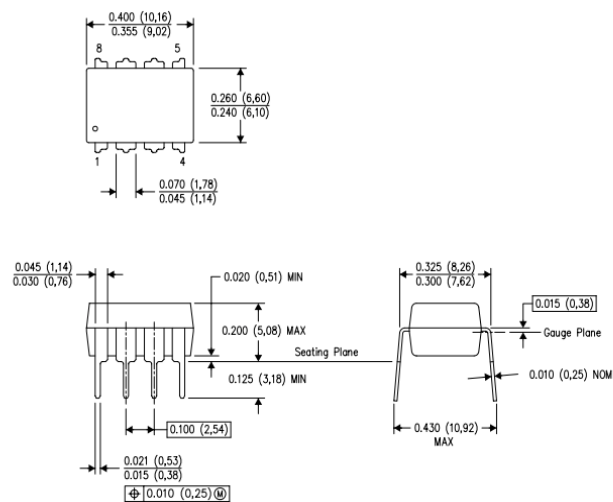
R_t 为特征匹配阻抗，典型值为120 Ω

封装包装

SOP8 (Package Outline Dimensions)



PDIP8 (Package Outline Dimensions)



NOTES: A. All linear dimensions are in inches (millimeters).
B. This drawing is subject to change without notice.